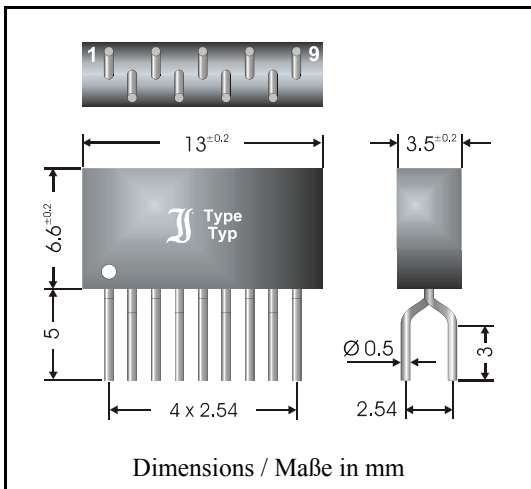


**Small Signal Diode Arrays**

**Dioden Sätze mit Allzweckdioden**



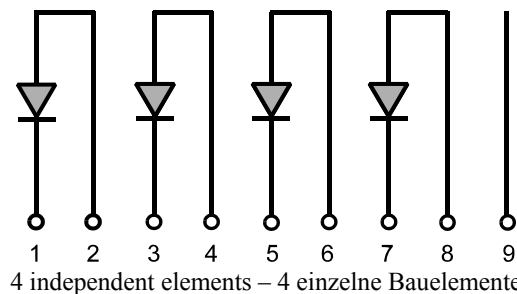
Nominal power dissipation 200 mW  
Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage 80 V  
Periodische Spitzensperrspannung

9 Pin-Plastic case 13 x 3.5 x 6.6 [mm]  
9 Pin-Kunststoffgehäuse

Weight approx. 0.6 g  
Gewicht ca.

Standard packaging: bulk see page 22  
Standard Lieferform: lose im Karton s. Seite 22



**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAN 403	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,  
for one diode operation only  
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

$I_{FAV}$  100 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  50 mA <sup>1)</sup>

Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last,  
für eine einzelne Diode  
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

$I_{FAV}$  100 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  50 mA <sup>1)</sup>

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$

$I_{FSM}$  500 mA

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	- 50...+150°C

Characteristics			Kennwerte
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	$V_F < 1.0\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	$I_R < 25\text{ nA}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA through/über}$ $I_R = 10\text{ mA to/auf } I_R = 1\text{ mA}$		$t_{rr} < 4\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA} < 85\text{ K/W}^1)$

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden